
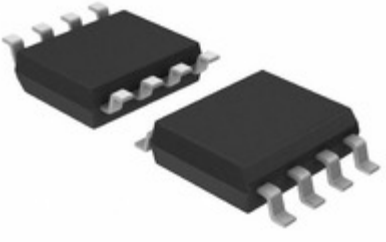
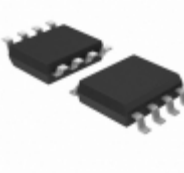
	<p>SI4688DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4688DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4688DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 83 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4688DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	83 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1580pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 8.9A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta)

SI4688DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4688DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4688DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4688DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4688-A10-GMR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN</p>	 <p>SI4689-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p>SI4688DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4688DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p>
 <p>SI4689-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p>SI4689-QFN-EVB Energy Micro (Silicon Labs) EVAL BOARD QFN SI4689</p>	 <p>SI4688-A10-GDR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 62WL CSP</p>	 <p>SI4688DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4688DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4688DY-T1-E3 Datenblatt	SI4688DY-T1-E3-Datenblätter	SI4688DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4688DY-T1-E3
SI4688DY-T1-E3 Electronic	SI4688DY-T1-E3-Komponenten	SI4688DY-T1-E3-Verteiler	SI4688DY-T1-E3-Bild	SI4688DY-T1-E3-Teil
SI4688DY-T1-E3 Preis	SI4688DY-T1-E3 Hersteller	SI4688DY-T1-E3 Bild	SI4688DY-T1-E3 Aktie	SI4688DY-T1-E3 Inventar
SI4688DY-T1-E3 Neu	SI4688DY-T1-E3 Original	SI4688DY-T1-E3 garantiert	SI4688DY-T1-E3 RFQ	SI4688DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited